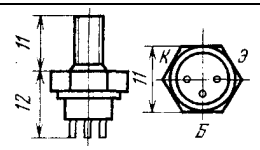
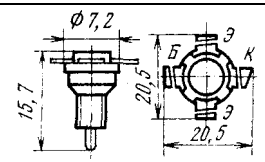
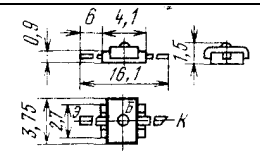
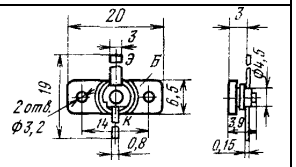
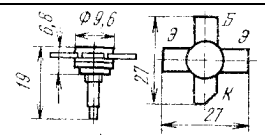
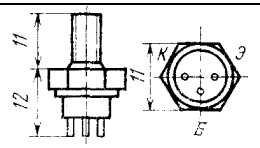
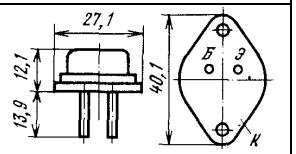
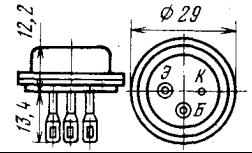
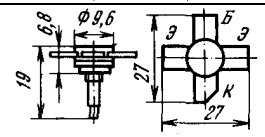
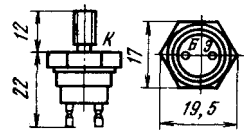
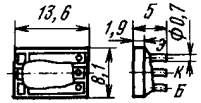
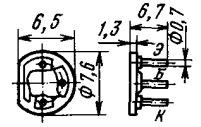
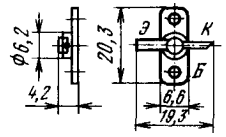
СПРАВОЧНИК ПО РАДИОДЕТАЛЯМ

КТ914А, КТ916, КТ918(А, Б), КТ919(А-Г), КТ920(А-Г), КТ921(А, Б), КТ922(А-Д), КТ925(А-Г), КТ926(А, Б), КТ927(А-В), КТ928(А, Б), КТ929А, КТ930(А, Б), КТ931А, КТ932(А-В), КТ933(А, Б), КТ934(А-Д), КТ935А, КТ936(А, Б), КТ937(А, Б)-2.

Тип прибора	Структура, технология	Рк max, Р*к,т max, Р**к,и max, мВт	frp, f*h21б, f**h21э, f***max, МГц	Uкбо max, U*кэг max, U**кэо max, В	Uэбо max, В	Iк max, I*к,и max, мА	Iкбо, I*кэг, I**кэо, мкА	h21э, h*21Э	Ск, С*12э, пф	r кэ нас, r бэ нас, Ом	Кш, дб г*б, Ом Р**вых, Вт	тк, пс t*рас, нс t**выкл, нс	Габаритный чертеж корпуса
КТ914А	p-n-p, ПЭ	7*Вт	>300	65	4	0,8 (1,5*) А	<2* (65 В)	10...50* (5 В; 0,25 А)	<12 (28 В)	12	>2,5** (400 М)	<20	
КТ916	n-p-n, ПЭ	30*Вт	>1100	55* (0,01 к)	3,5	2 (4*) А	<25 мА (55 В)	35* (5 В; 0,25 А)	<20 (30 В)	0,8	>20** (1 ГГц)	<10	
КТ918А КТ918Б	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	2,5*Вт 2,5*Вт	>800 >1000	30 30	2,5 2,5	250 250	<2 мА (30 В) <2 мА (30 В)	- -	<4,2 (15 В) <4,2 (15 В)	- -	>0,25** (3 ГГц) >0,5** (3 ГГц)	<15 <4	
КТ919А КТ919Б КТ919В КТ919Г	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	10*Вт 5*Вт 3,25*Вт 10*Вт	>1350 >1350 >1350 >1350	45 45 45 45	3,5 3,5 3,5 3,5	0,7 (1,5*) А 0,35 (0,7*) А 0,2 (0,4*) А 0,7 (1,5*) А	<10 мА (45 В) <5 мА (45 В) <2 мА (45 В) <10 мА (45 В)	- - - -	<10 (28 В) <6,5 (28 В) <5 (28 В) <12 (28 В)	- - - -	>0,35** (2 ГГц) >1,6** (2 ГГц) >0,8** (2 ГГц) >3** (2 ГГц)	<2,2 <2,2 <2,2 <2,2	
КТ920А КТ920Б КТ920В КТ920Г	n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ n-p-n, ПЭ	5*Вт (50 °С) 10*Вт (50 °С) 25*Вт (50 °С) 15*Вт (50 °С)	>400 >400 >400 >350	36 36 36 36	4 4 4 4	0,25 (1*) А 1 (2*) А 3 (7*) А 3 (7*) А	<2* мА (36 В) <4* мА (36 В) <7,5* мА (36 В) <7,5* мА (36 В)	- - - -	<15 (10 В) <25 (10 В) <75 (10 В) <75 (10 В)	- - - -	2** (175 М) 5** (175 М) 20** (175 М) 15** (175 М)	<2,0 <2,0 <2,0 <2,0	
КТ921А КТ921Б	n-p-n, П n-p-n, П	12,5*Вт (75 °С) 12,5*Вт (75 °С)	>90 >90	65* (0,1 к) 65* (0,1 к)	4 4	3,5 А 3,5 А	<10 мА (70 В) <10 мА (70 В)	>10* (10 В; 1 А) >10* (10 В; 1 А)	50 (20 В) 50 (20 В)	<1,8 <1,8	>12,5** (60 М) >12,5** (60 М)	<22 <22	

Тип прибора	Структура, технология	Рк max, Р*к,т max, Р**к,и max, мВт	fгр, f*h21б, f**h21э, f***max, МГц	Uкбо max, U*кэг max, U**кэо max, В	Uэбо max, В	Iк max, I*к,и max, мА	Iкбо, I*кэг, I**кэо, мкА	h21э, h*21Э	Ск, С*12э, пф	r кэ нас, r бэ нас, Ом	Кш, дб r*б, Ом Р**вых, Вт	tк, пс t*рас, нс t**выкл, нс	Габаритный чертеж корпуса
КТ922А	n-p-n, ПЭ	8*Вт (40 °С)	>300	65* (0,1 к)	4	0,8 (1,5*) А	<5* мА (65 В)	-	<15 (28 В)	-	5** (175 М)	<20	
КТ922Б	n-p-n, ПЭ	20*Вт (40 °С)	>300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	<20* мА (65 В)	-	<35 (28 В)	-	20** (175 М)	<20	
КТ922В	n-p-n, ПЭ	40*Вт (40 °С)	>300	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	<40* мА (65 В)	-	<65 (28 В)	-	40** (175 М)	<25	
КТ922Г	n-p-n, ПЭ	20*Вт (40 °С)	>300	65* (0,1 к)	4	1,5 (4,5*) А	<20* мА (65 В)	-	<35 (28 В)	-	17** (175 М)	<20	
КТ922Д	n-p-n, ПЭ	20*Вт (40 °С)	>250	65* (0,1 к)	4	3 (9*) А	<40* мА (65 В)	-	<65 (28 В)	-	35** (175 М)	<25	
КТ925А	n-p-n, ПЭ	5,5*Вт (40 °С)	>500	36* (0,1 к)	4	0,5 (1*) А	<7 мА (36 В)	8* (5 В; 0,2 А)	<15 (12,6 В)	-	2** (320 М)	<20	
КТ925Б	n-p-n, ПЭ	11*Вт (40 °С)	>500	36* (0,1 к)	4	1 (3*) А	<12 мА (36 В)	-	<30 (12,6 В)	-	5** (320 М)	<35	
КТ925В	n-p-n, ПЭ	25*Вт (40 °С)	>450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	<30 мА (36 В)	17* (5 В; 0,2 А)	<60 (12,6 В)	-	20** (320 М)	<40	
КТ925Г	n-p-n, ПЭ	25*Вт (40 °С)	>450	36* (0,1 к)	3,5	3,3 (8,5*) А	<30 мА (36 В)	-	<60 (12,6 В)	-	15** (320 М)	<40	
КТ926А	n-p-n, МП	50*Вт (50 °С)	>51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	<25 мА (150 В)	10...60* (7 В; 15 А)	-	<0,17	-	-	
КТ926Б	n-p-n, МП	50*Вт (50 °С)	>51	150* (0,01 к)	5	15 (25*) А	<25 мА (150 В)	10...60* (7 В; 15 А)	-	<0,25	-	-	
КТ927А	n-p-n, ПЭ	83,3*Вт (75 °С)	>105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	<40* мА (70 В)	>15* (6 В; 5 А)	<190 (28 В)	<0,07	>75** (20 М)	-	
КТ927Б	n-p-n, ПЭ	83,3*Вт (75 °С)	>105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	<40* мА (70 В)	>25* (6 В; 5 А)	<190 (28 В)	<0,07	>75** (20 М)	-	
КТ927В	n-p-n, ПЭ	83,3*Вт (75 °С)	>105	70* (0 к)	3,5	10 (30*) А	<40* мА (70 В)	>40* (6 В; 5 А)	<190 (28 В)	<0,07	>75** (20 М)	-	
КТ928А	n-p-n, ПЭ	0,5*Вт (36*)	>250	60	5	0,8 (1,2*) А	<1 (60 В)	20...100* (5 В; 0,15 А)	<12 (10 В)	<3,3	-	<250*	
КТ928Б	n-p-n, ПЭ	0,5*Вт (36*)	>250	60	5	0,8 (1,2*) А	<1 (60 В)	50...200* (5 В; 0,15 А)	<12 (10 В)	<3,3	-	<250*	
КТ929А	n-p-n, ПЭ	6*Вт (40 °С)	>700	30* (0,1 к)	3	0,8 (1,5*) А	<5* мА (30 В)	>25* (5 В; 0,7 А)	<20 (8 В)	-	>2** (175 М)	<25	
КТ930А	n-p-n, ПЭ	75 Вт (40 °С)	>450	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	<20* мА (50 В)	40* (5 В; 0,5 А)	<80 (28 В)	-	>40** (400 М)	8	
КТ930Б	n-p-n, ПЭ	120 Вт (40 °С)	>600	50* (0,1 к)	4	6 (10*) А	<100* мА (50 В)	50* (5 В; 0,5 А)	<170 (28 В)	-	>75** (400 М)	11	
КТ931А	n-p-n, ПЭ	150 Вт (40 °С)	>250	60* (0,1 к)	4	15 А	<20* мА (60 В)	25* (5 В; 0,5 А)	<240 (28 В)	0,18	>80** (400 М)	18	

Тип прибора	Структура, технология	Pк max, P*к,т max, P**к,и max, мВт	fгр, f*h21б, f**h21э, f***max, МГц	Uкбо max, U*кэг max, U**кэо max, В	Uэбо max, В	Iк max, I*к,и max, мА	Iкбо, I*кэг, I**кэо, мкА	h21э, h*21Э	Cк, C*12э, пф	r кэ нас, r бэ нас, Ом	Кш, дб r*б, Ом P**вых, Вт	tк, пс t*рас, нс t**выкл, нс	Габаритный чертеж корпуса
КТ932А	p-n-p, ПЭ	20 Вт (50 °С)	>40	80	4,5	2 А	<1,5* мА (80 В)	>15* (3 В; 1,5 А)	<300 (20 В)	<1	-	-	
КТ932Б	p-n-p, ПЭ	20 Вт (50 °С)	>60	80	4,5	2 А	<1,5* мА (60 В)	>30* (3 В; 1,5 А)	<300 (20 В)	<1	-	-	
КТ932В	p-n-p, ПЭ	20 Вт (50 °С)	>40	40	4,5	2 А	<1,5* мА (40 В)	>40* (3 В; 1,5 А)	<300 (20 В)	<1	-	-	
КТ933А	p-n-p, ПЭ	5* Вт (50 °С)	>75	80	4,5	0,5 А	<0,5 мА (80 В)	>15* (3 В; 0,4 А)	<70 (20 В)	<3,75	-	-	
КТ933Б	p-n-p, ПЭ	5* Вт (50 °С)	>75	60	4,5	0,5 А	<0,5 мА (60 В)	>30* (3 В; 0,4 А)	<70 (20 В)	<3,75	-	-	
КТ934А	n-p-n, ПЭ	7,5 Вт	>500	60* (0,01 к)	4	0,5 А	<7,5 мА (60 В)	50* (5 В; 0,1 А)	<9 (28 В)	2	>3** (400 М)	<20	
КТ934Б	n-p-n, ПЭ	15 Вт	>500	60* (0,01 к)	4	1 А	<15 мА (60 В)	50* (5 В; 0,15 А)	<16 (28 В)	1	>12** (400 М)	<20	
КТ934В	n-p-n, ПЭ	30 Вт	>500	60* (0,01 к)	4	2 А	<30 мА (60 В)	50* (5 В; 0,25 А)	<32 (28 В)	0,5	>25** (400 М)	<20	
КТ934Г	n-p-n, ПЭ	15 Вт	>450	60* (0,01 к)	4	1 А	<15 мА (60 В)	-	<16 (28 В)	-	>10** (400 М)	<25	
КТ934Д	n-p-n, ПЭ	30 Вт	>450	60* (0,01 к)	4	2 А	<30 мА (60 В)	-	<32 (28 В)	-	>20** (400 М)	<25	
КТ935А	n-p-n, МПЭ	60* Вт (50 °С)	>51	80* (0,01 к)	5	20 (30*) А	<30 мА (80 В)	20...100* (4 В; 15 А)	<800 (10 В)	<0,066	-	<700**	
КТ936А	n-p-n, ПЭ	28 Вт (75 °С)	-	60	3,5	3,3 А	<10 мА (60 В)	>6* (3 В; 0,1 А)	-	-	-	-	
КТ936Б	n-p-n, ПЭ	83,3 Вт (75 °С)	-	60	3,5	10 А	<30 мА (60 В)	>6* (3 В; 0,1 А)	-	-	-	-	
КТ937А-2	n-p-n, ПЭ	3,6 Вт	6500	25	2,5	250	<2 мА (25 В)	-	<5,5 (20 В)	-	>1,6** (5 ГГц)	0,78	
КТ937Б-2	n-p-n, ПЭ	7,4 Вт	6500	25	2,5	450	<5 мА (25 В)	-	<7,5 (20 В)	-	>3,2** (5 ГГц)	0,6	

Для создания этого документа использовалась литература :
Издательство “ Радио и связь ” “Элементы схем бытовой радиоаппаратуры – диоды – транзисторы ”
(авторы:А. И. Аксенов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин)